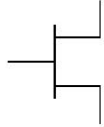
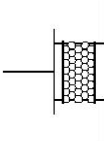
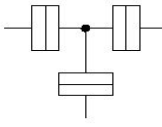
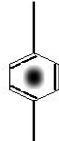
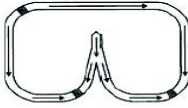
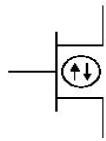


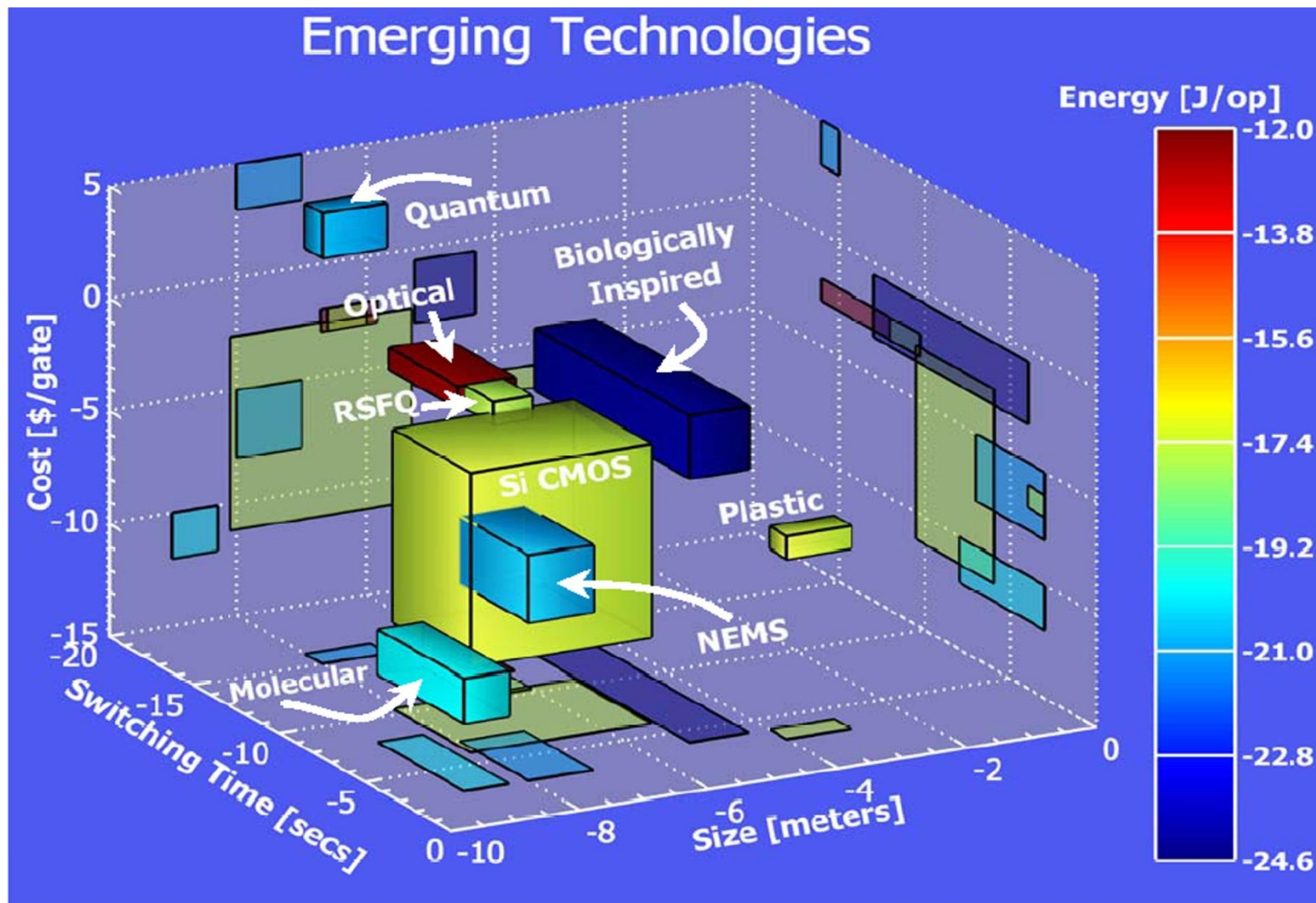
КМОП технология вблизи физических пределов масштабирования

В.П. Попов

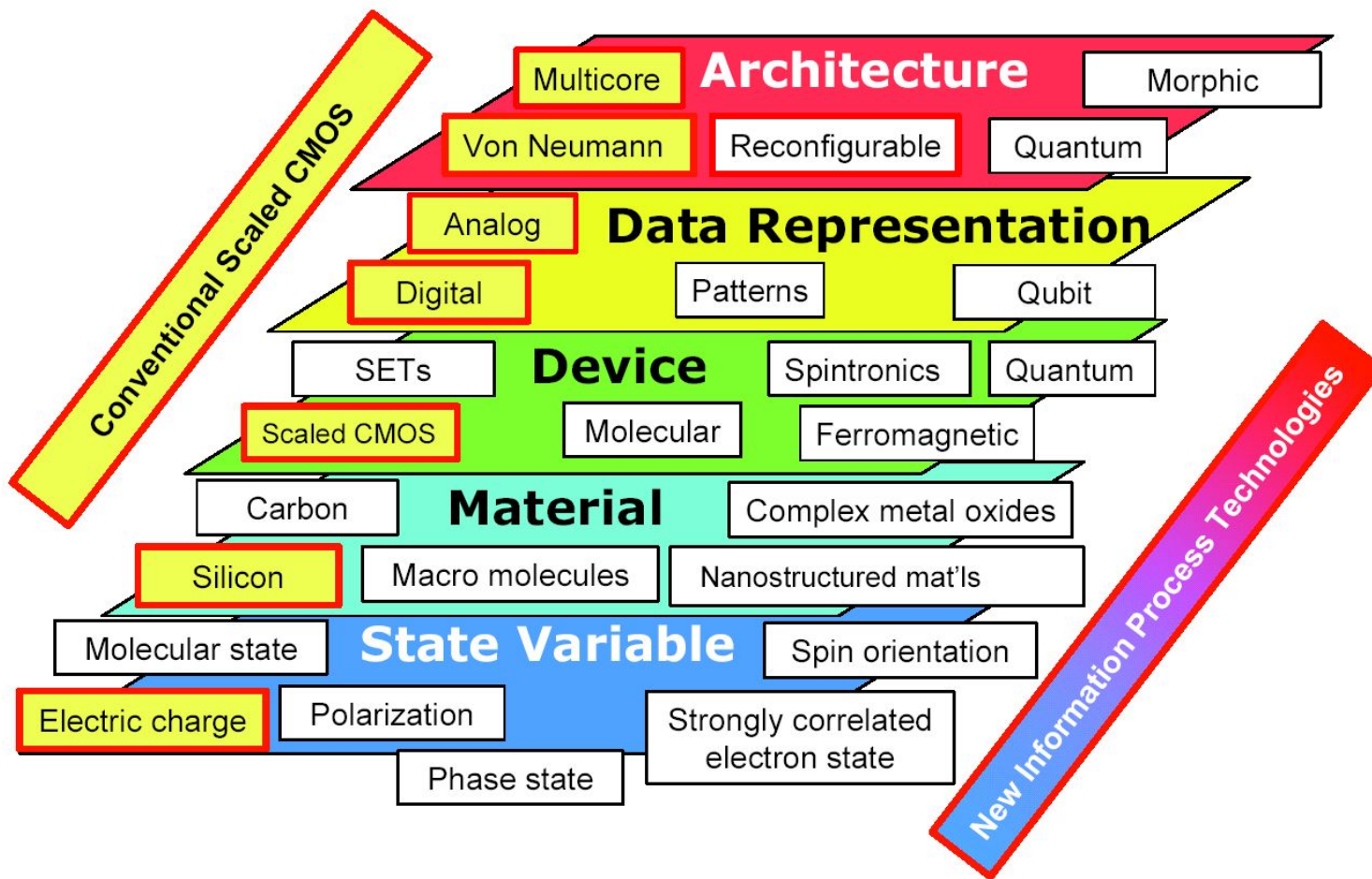
Прогнозируемые и достигнутые параметры логических элементов

Device								
		FET Extension						
		FET [A]	1D structures	Channel replacement	SET	Molecular	Ferromagnetic logic	Spin transistor
Typical example devices		Si CMOS	CNT FET NW FET NW hetero-structures Nanoribbon transistors with graphene	III-V compound semiconductor and Ge channel replacement	SET	Crossbar latch Molecular transistor Molecular QCA	Moving domain wall M: QCA	Spin Gain transistor Spin FET Spin Torque Transistor
Cell Size (spatial pitch) [B]	Projected	100 nm	100 nm [D]	300 nm [I]	40 nm [O]	10 nm [U]	140 nm [Y]	100 nm [C]
	Demonstrated	590 nm	~1.5 μm [E]	1700 nm [J]	~200 nm [K, L]	~2 μm [V]	250 nm [Z, AA]	100 μm [AB]
Density (device/cm ²)	Projected	1E10	4.5E9	6.1E9	6E10	1E12	5E9	4.5E9
	Demonstrated	2.8E8	4E7	3.5E7	~2E9	2E7	1.6E9	1E4
Switch Speed	Projected	12 THz	6.3 THz [F]	>1 THz	10 THz [Q]	1 THz [W]	1 GHz [Y]	40 GHz [AC]
	Demonstrated	1.5 THz	200 MHz [G]	>300 GHz	2 THz [R]	100 Hz [V]	30 Hz [Z, AA]	Not known
Circuit Speed	Projected	61 GHz	61 GHz [C]	61 GHz [C]	1 GHz [O]	1 GHz [U]	10 MHz [Y]	Not known
	Demonstrated	5.6 GHz	220 Hz [H]	Data not available	1 MHz [P]	100 Hz [V]	30 Hz [Z]	Not known
Switching Energy, J	Projected	3E-18	3E-18	3.00E-18	1×10 ⁻¹⁸ [O] [>1.5×10 ⁻¹⁷] [S]	5E-17 [X]	~1E-17 [Z]	3E-18
	Demonstrated	1E-16	1E-11 [H]	1E-16 [J]	8×10 ⁻¹⁷ [T] [>1.3×10 ⁻¹⁴] [S]	3E-7 [V]	6E-18 [AA]	Not known
Binary Throughput, GBit/ns/cm ²	Projected	238	238	61	10	1000	5E-2	Not known
	Demonstrated	1.6	1E-8	Data not available	2E-4	2E-9	5E-8	Not known
Operational Temperature		RT	RT	RT	RT [M, N]	RT	RT	RT
Materials System		Si	CNT, Si, Ge, III-V, In ₂ O ₃ , ZnO, TiO ₂ , SiC,	InGaAs, InAs, InSb	III-V, Si, Ge,	Organic molecules	Ferromagnetic alloys	Si, III-V, complex metals oxides
Research Activity [AD]			379	62	91	244	32	122

Технико-экономические параметры элементных базисов



Развивающиеся и поисковые информационные технологии

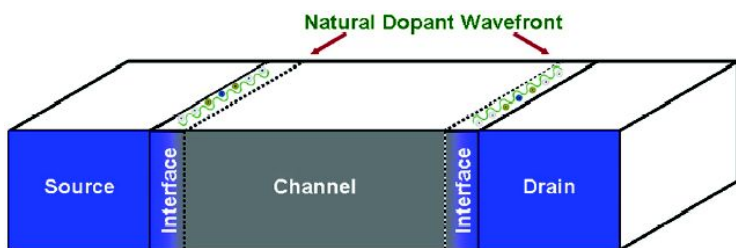
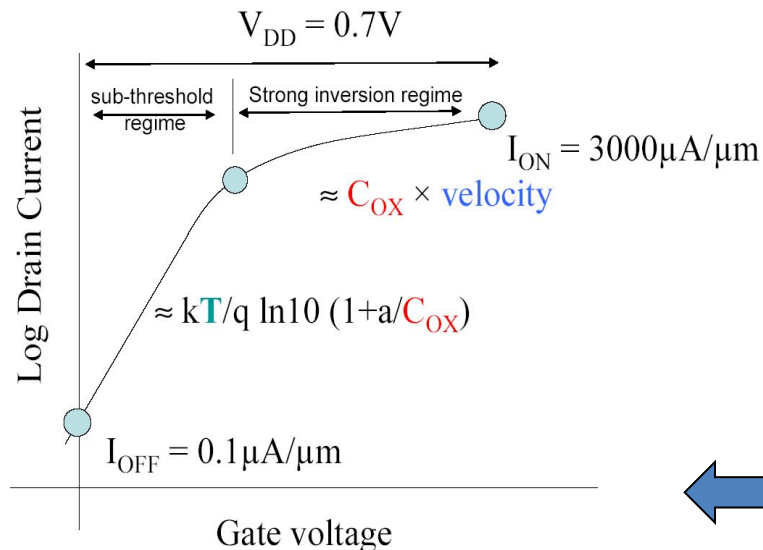


Принцип электростатического подобия и закон Мура

$$P_{dyn} = n \cdot I_{on} \cdot V_{DD} \rightarrow k^2 \cdot k \cdot k = const \quad k \sim 0.7$$

$$F_{dyn} = I_{on} / (C_{ox} \cdot W \cdot L \cdot V_{DD}) \rightarrow k / (k^{-1} \cdot k \cdot k \cdot k) = k^{-1}$$

Текущее масштабирование по мощности и частоте для схем на классических КМОП транзисторах



* $L_g = 5 \text{ nm}$ n-MOSFET

$L_{ch} = 6 \pm 3 \text{ nm}$ из-за флуктуаций $n^+_{s,D}$

Ограничения нанотранзисторов:

Предел масштабирования по туннельному току затвора I_G достигнут при 90 нм норме
 $GOT = 1.5 \text{ nm}$

Для 45 нм – high-k диэлектрики $GOT = 1.0 \text{ nm}$ Для 14 нм – $GOT = 0.5 \text{ nm}$ (SiO_2)

При 14 нм проектной норме (2015 г.)* – баллистический режим ($L < \lambda$), но туннелирование S-D

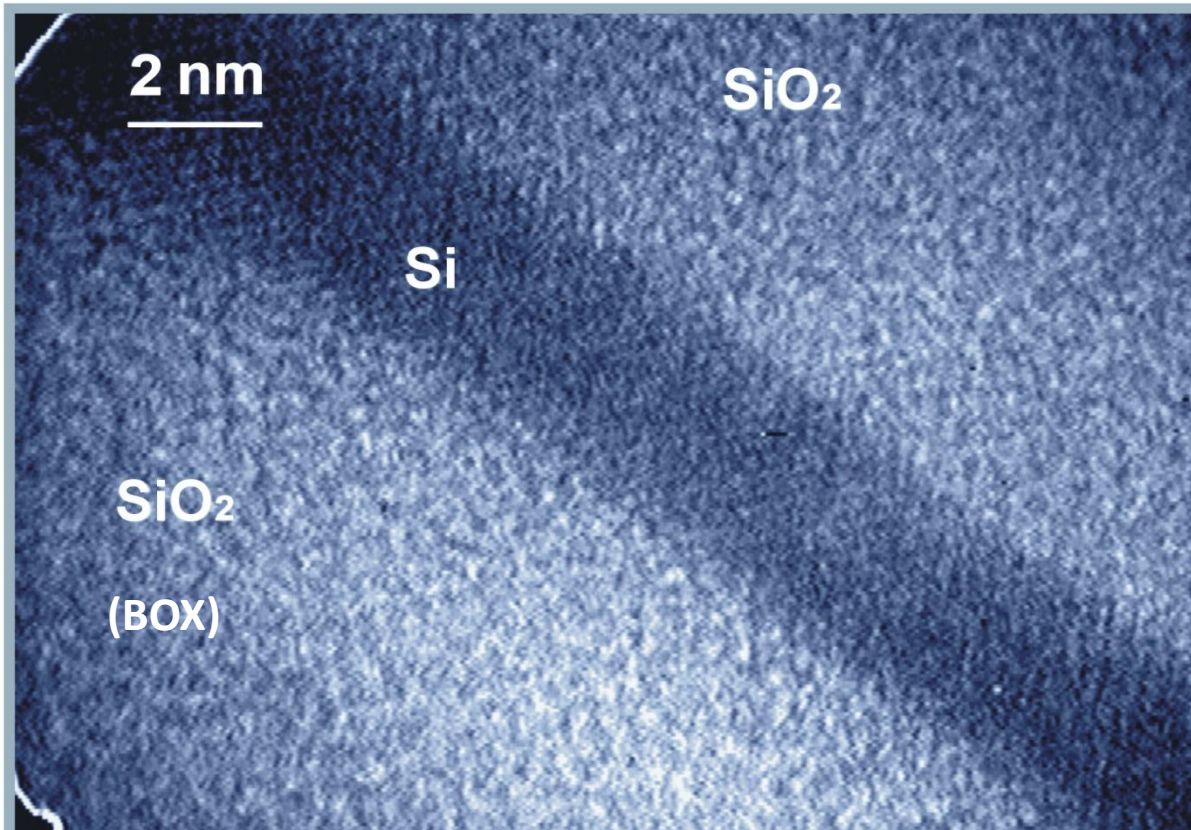
При $L=3 \text{ nm}$ (10 нм норма 2020 г.) - изменения зонной структуры (скорости, ёмкости)

- Снижение температуры
- Уменьшение ёмкости оксида
- Увеличение скорости

.....или инженерия канала?



Silicon-on-Isolator (SOI) ultra-thin structure



Electron microphotography with atomic resolution of cross-section of monocrystalline ultra-thin cut-off 3 nm silicon layer between upper oxide and buried dielectric of SOI-structure

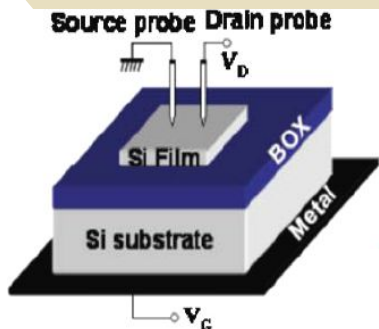
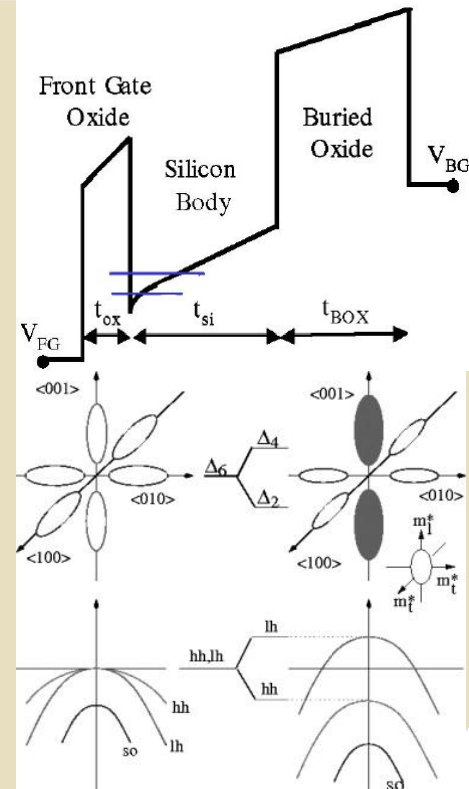
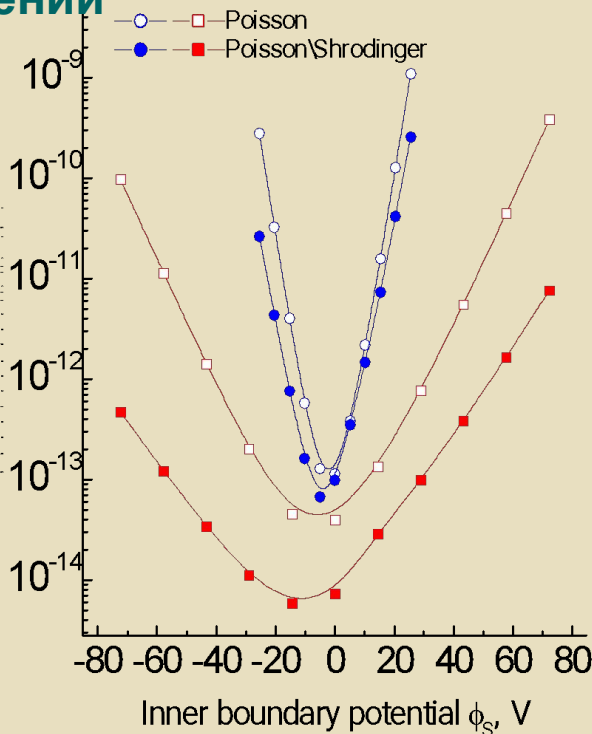
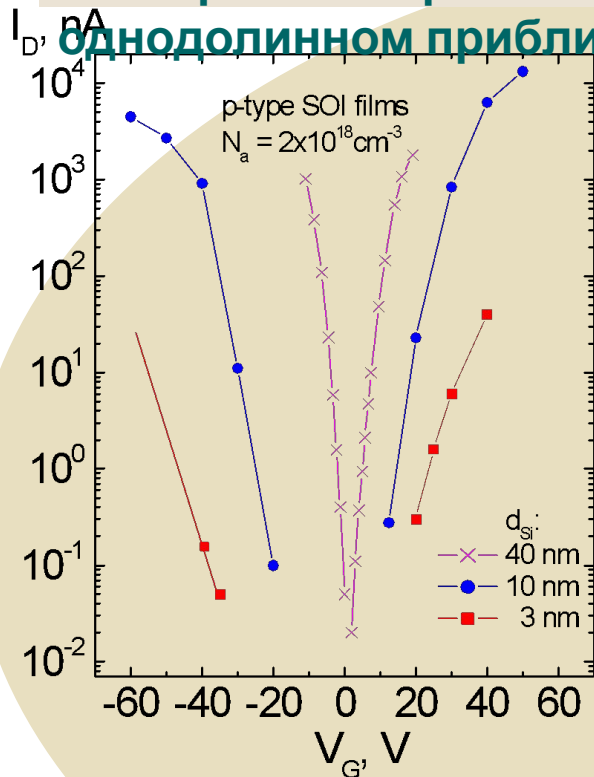
World record presented in 1999 at E-MRS Meeting

V.P. Popov, I.V. Antonova, V.F. Stas et al., J. Mater. Sci. Eng. B, 73, 82 (2000)

Проводимость 3 нм плёнок Si в КНИ: измерения ВАХ точно-контактного псевдо МОП-транзистора и расчет DOS в ОДП

Эксперимент и расчет плотности состояний (DOS) плёнки Si в

однодолинном приближении



$$E_{ll} = \frac{h^2 \pi^2}{2m_{ll}^* d_{si}^2} = 23,5 \text{ мэВ}$$

$$E_l = \frac{h^2 \pi^2}{2m_l d_{si}^2} = 19,8 \text{ мэВ}$$

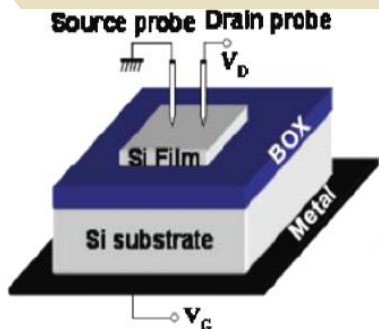
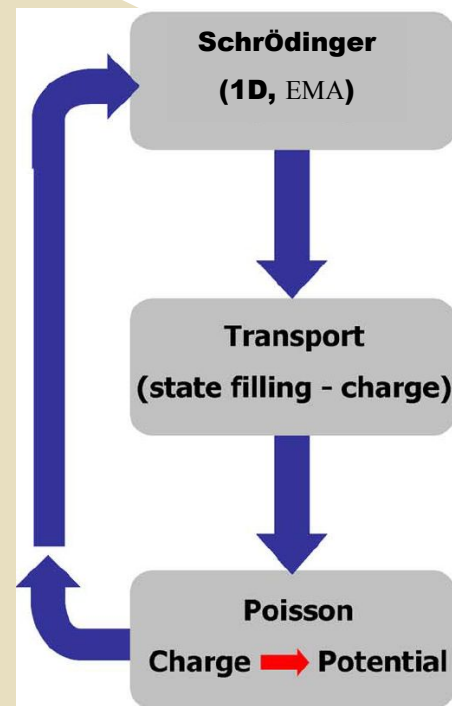
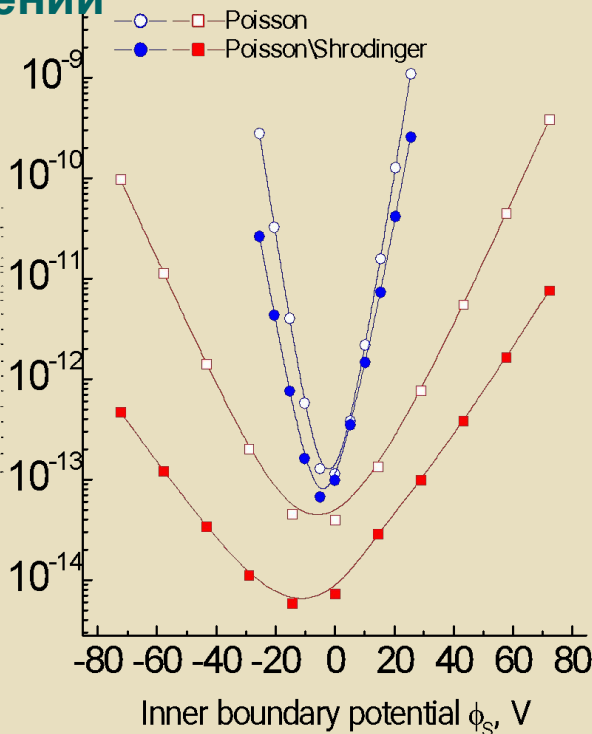
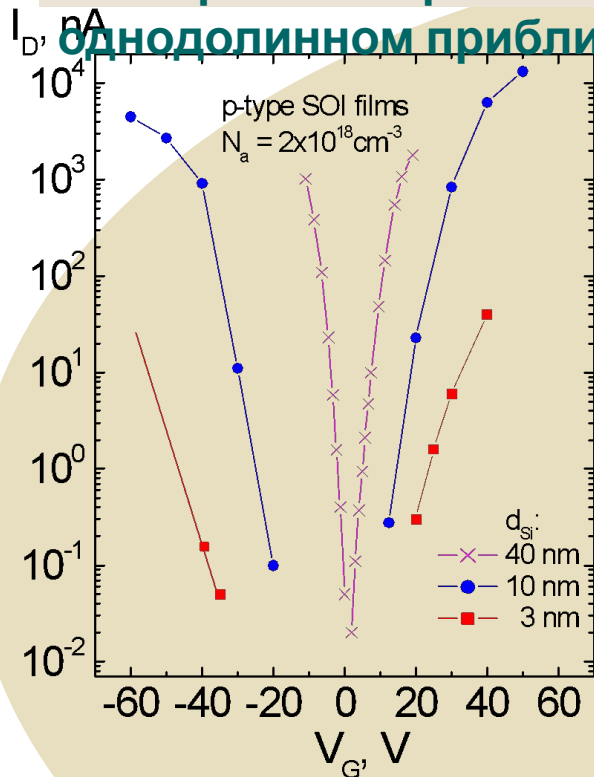
$$E_i^{L,T} = \left(\frac{\hbar^2}{2m_{L,T}} \right) \left(\frac{3\pi q E_{eff,i}^{L,T}}{2} \cdot \eta_i \right)^{2/3}$$

Квантовые поправки в проводимость 3 нм канала – 1-2 порядка

Проводимость 3 нм плёнок Si в КНИ: измерения ВАХ точно-контактного псевдо МОП-транзистора и расчет DOS в ОДП

Эксперимент и расчет плотности состояний (DOS) плёнки Si в

однодолинном приближении



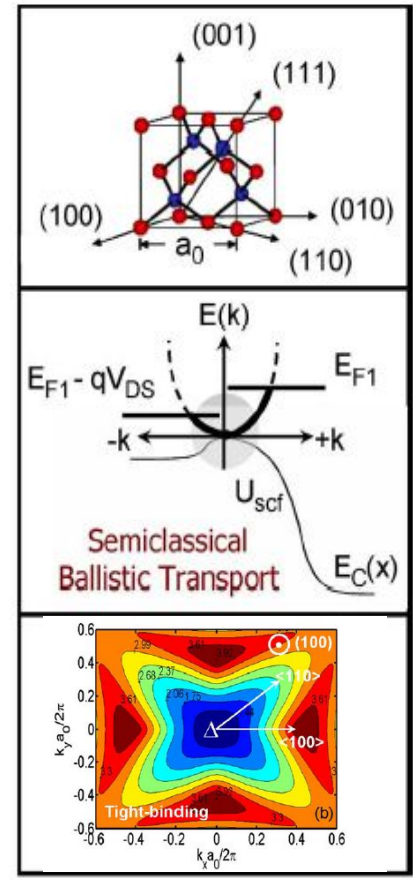
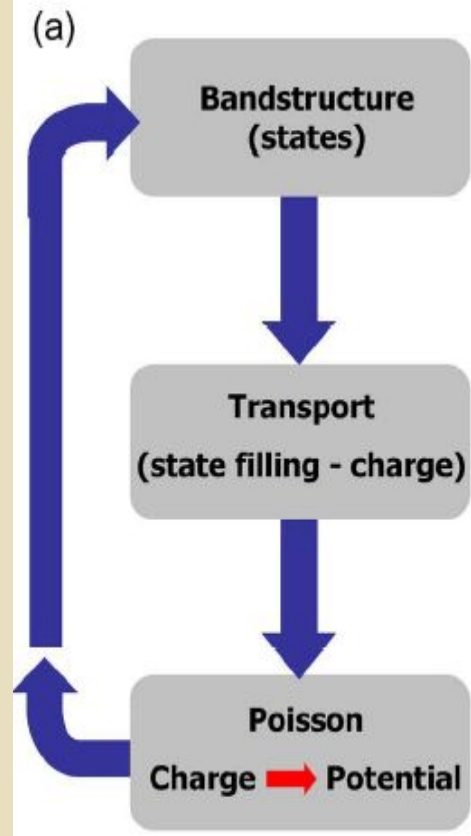
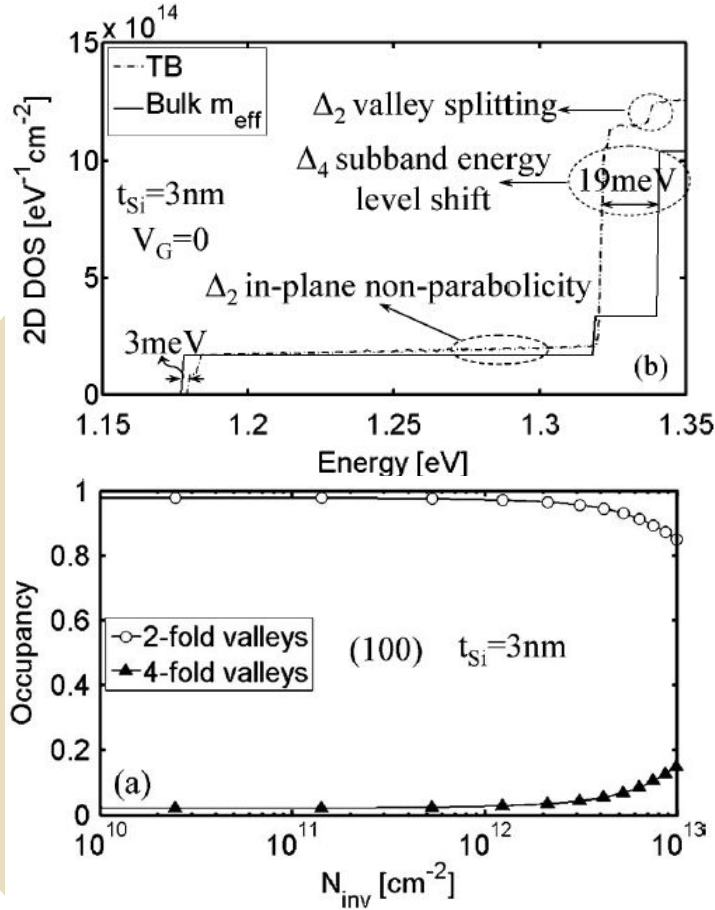
$$E_{II} = \frac{h^2 \pi^2}{2m_{II}^* d_{Si}^2} = 23,5 \text{ мэВ}$$

$$E_I = \frac{h^2 \pi^2}{2m_I d_{Si}^2} = 19,8 \text{ мэВ}$$

$$E_i^{L,T} = \left(\frac{\hbar^2}{2m_{L,T}} \left(\frac{3\pi q E_{eff\ i}^{L,T}}{2} \cdot \eta_i \right)^{2/3} \right)^{2/3}$$

Квантовые поправки в проводимость 3 нм канала – 1-2 порядка

Проводимость 3 нм пленок Si в КНИ: расчет DOS в ЕМА и ТВ



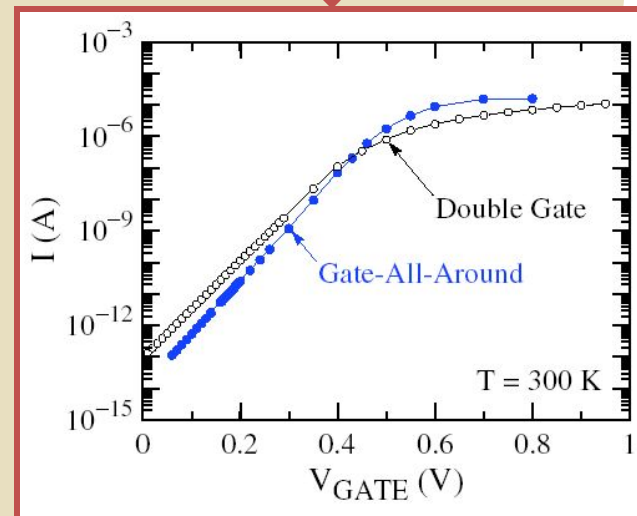
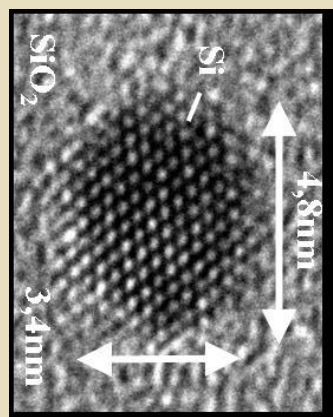
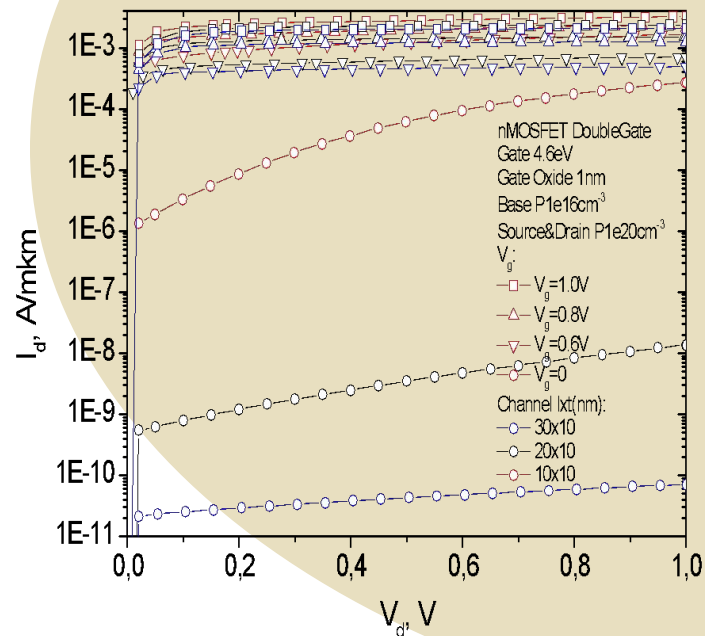
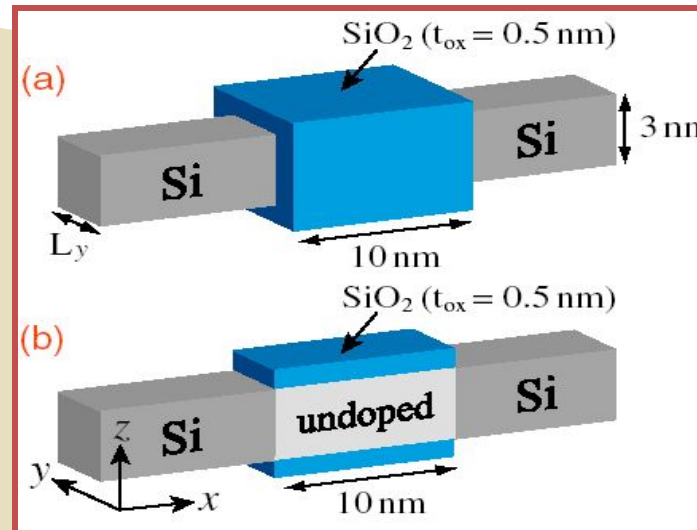
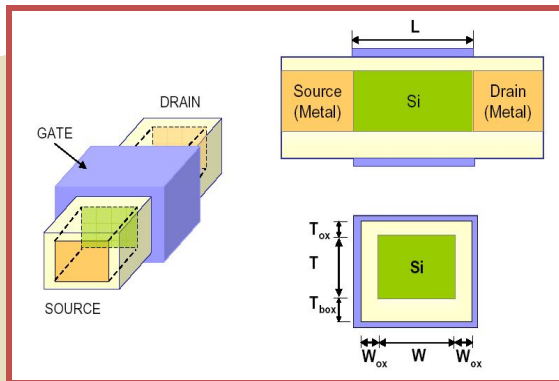
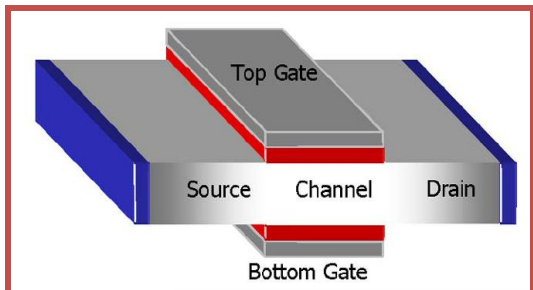
$$E_{II} = \frac{h^2 \pi^2}{2m_{\text{eff}}^* d^2_{\text{Si}}} = 23,5 \text{ мЭВ}$$

$$E_I = \frac{h^2 \pi^2}{2m_1 d^2_{\text{Si}}} = 19,8 \text{ мЭВ}$$

www.nanohu.org

Квантовые поправки определяются зонной структурой и зарядом

Переключение тока (on-off) в двухзатворном (DG) и нанопроволочном (SNW) транзисторах



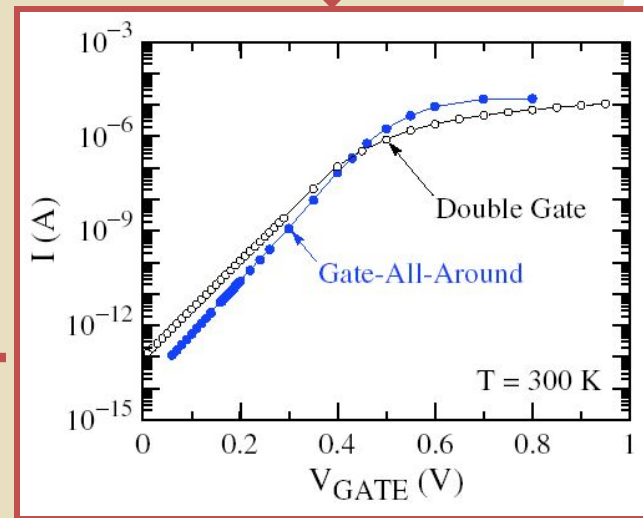
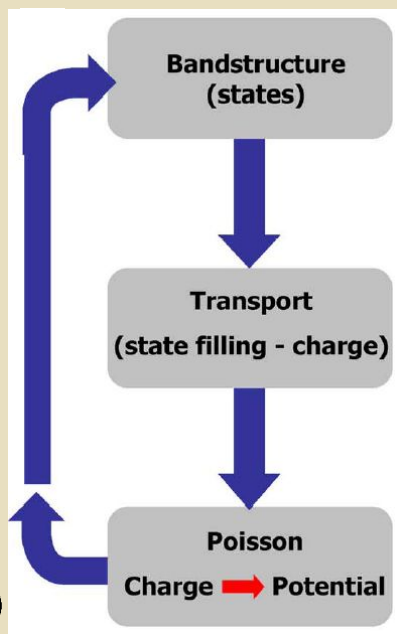
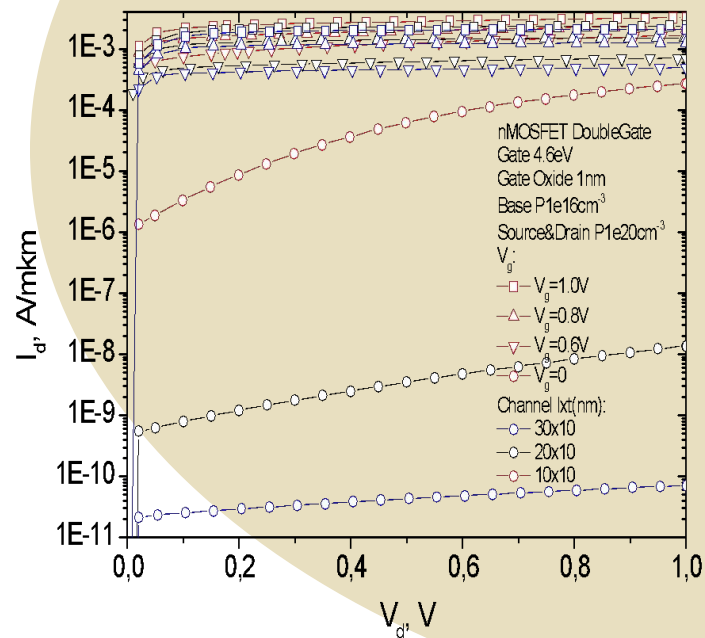
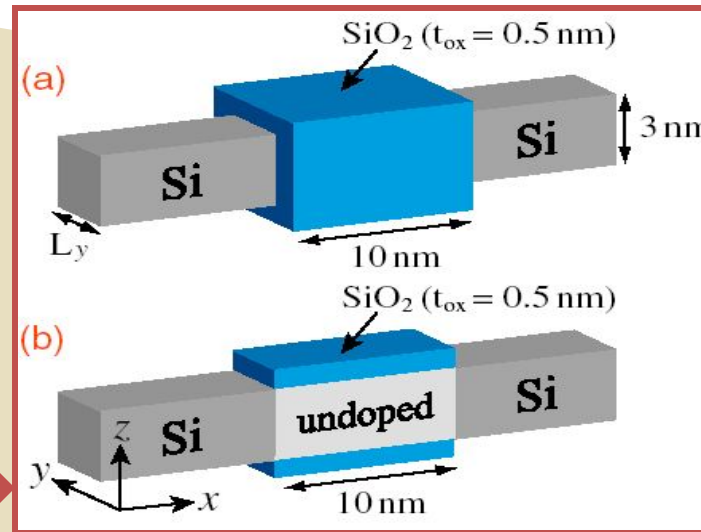
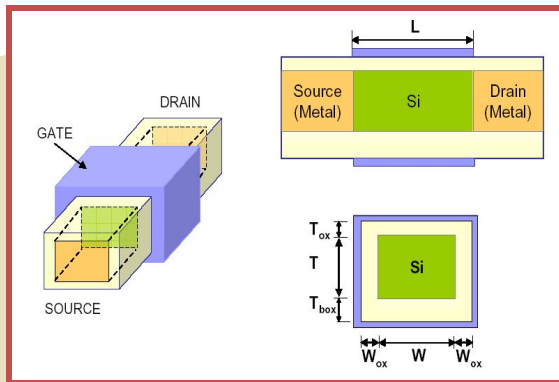
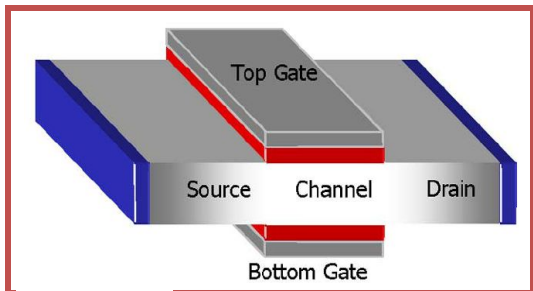
O.V. Naumova, M.A. Ilnitsky, L.N. Safronov, V.P. Popov.
 Semicond., v. 41, p.103-109, 2007

www.nanohub.org M. Lundstrom et al. IEEE Trans. on Elect. Dev., 55, 1286, 2008

M.Shin

M.Shin, IEEE Transactions On Nanotechnology 6, 230 (2007)

Переключение тока (on-off) в двухзатворном (DG) и нанопроволочном (SNW) транзисторах



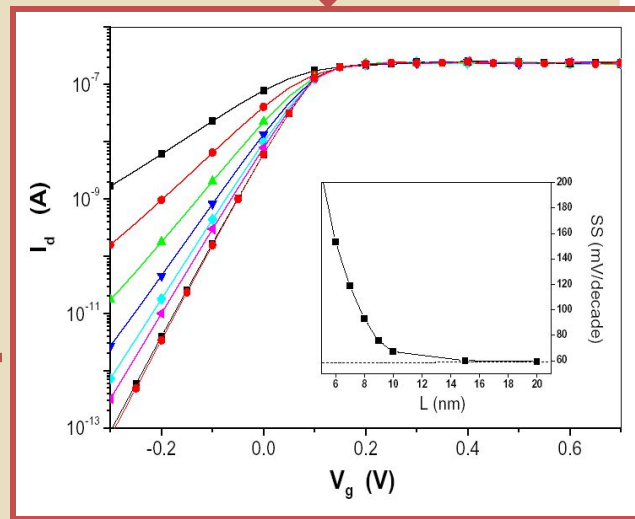
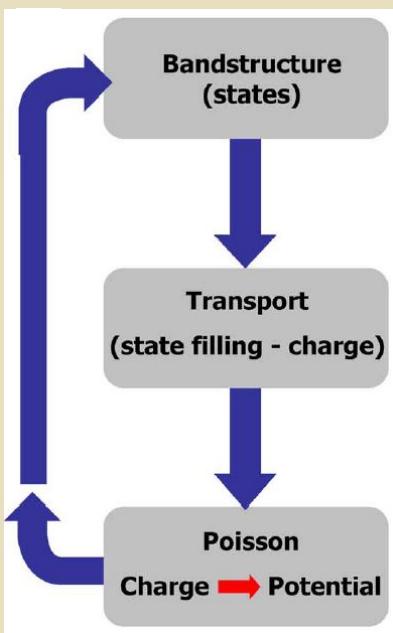
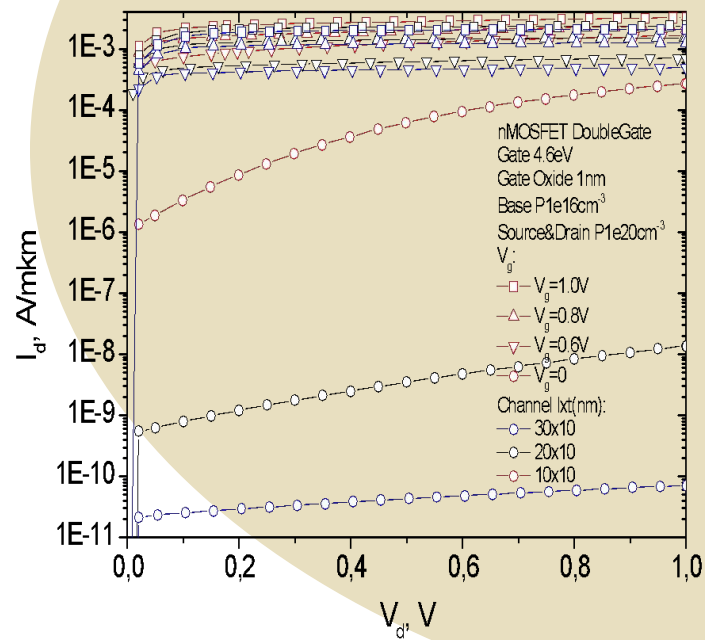
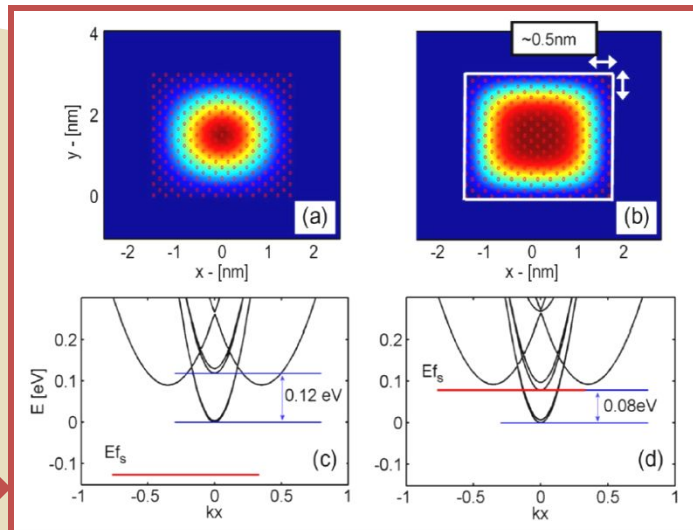
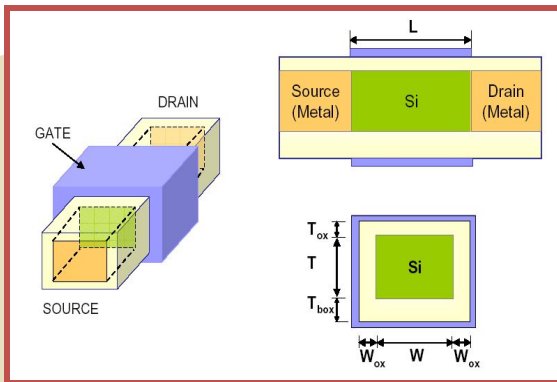
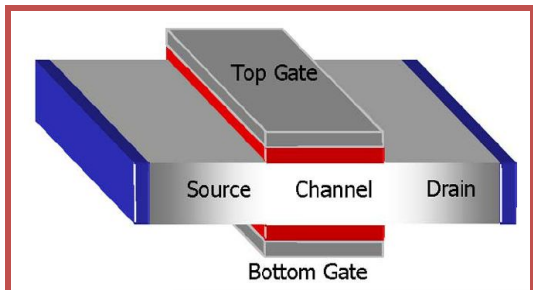
O.V. Naumova, M.A. Ilnitsky, L.N. Safronov, V.P. Popov.
 Semicond., v. 41, p.103-109, 2007

www.nanohub.org M. Lundstrom et al. IEEE Trans. on Elect. Dev., 55, 1286, 2008

M.Shin

M.Shin, IEEE Transactions On Nanotechnology 6, 230 (2007)

Переключение тока (on-off) в двухзатворном (DG) и нанопроволочном (SNW) транзисторах



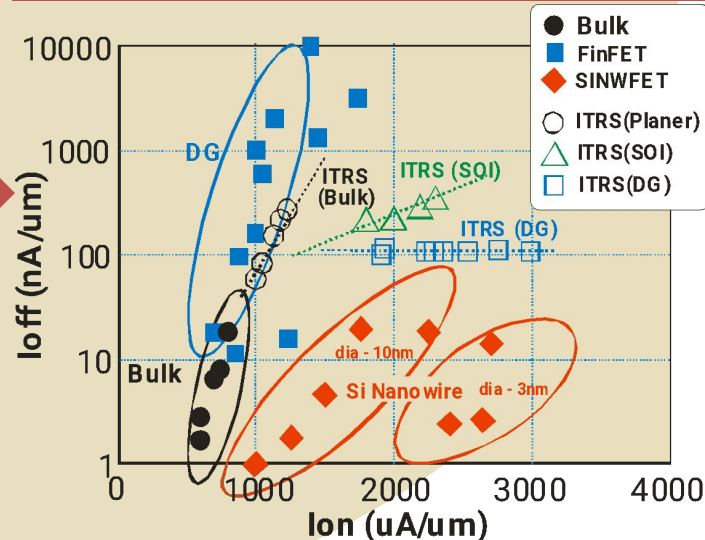
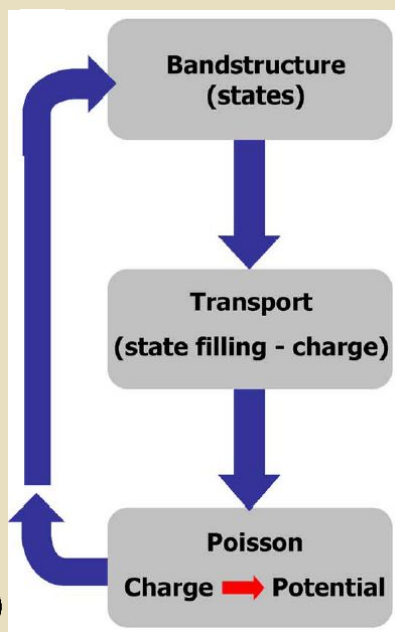
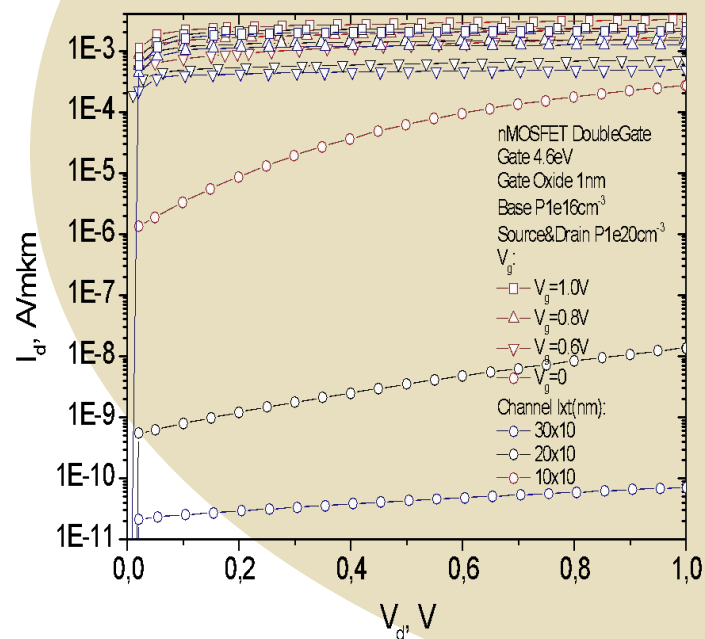
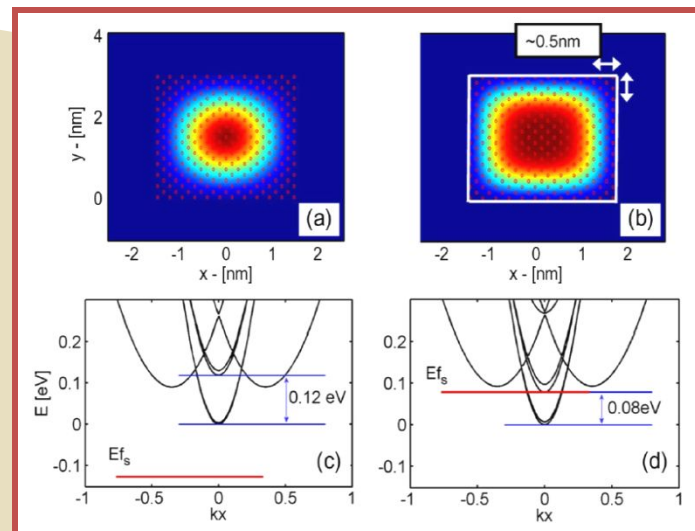
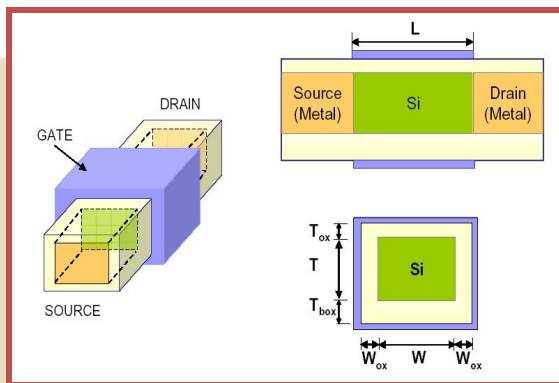
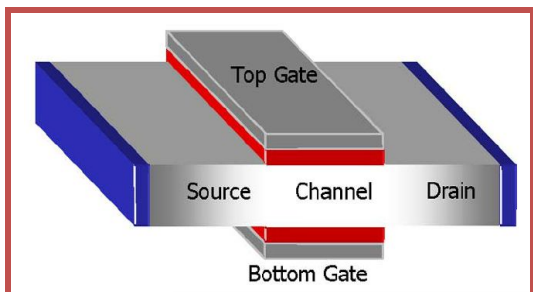
O.V. Naumova, M.A. Ilnitsky, L.N. Safronov, V.P. Popov.
 Semicond., v. 41, p.103-109, 2007

www.nanohub.org M. Lundstrom et al. IEEE Trans. on Elect. Dev., 55, 1286, 2008

M.Shin

M.Shin, IEEE Transactions On Nanotechnology 6, 230 (2007)

Переключение тока (on-off) в двухзатворном (DG) и нанопроволочном (SNW) транзисторах



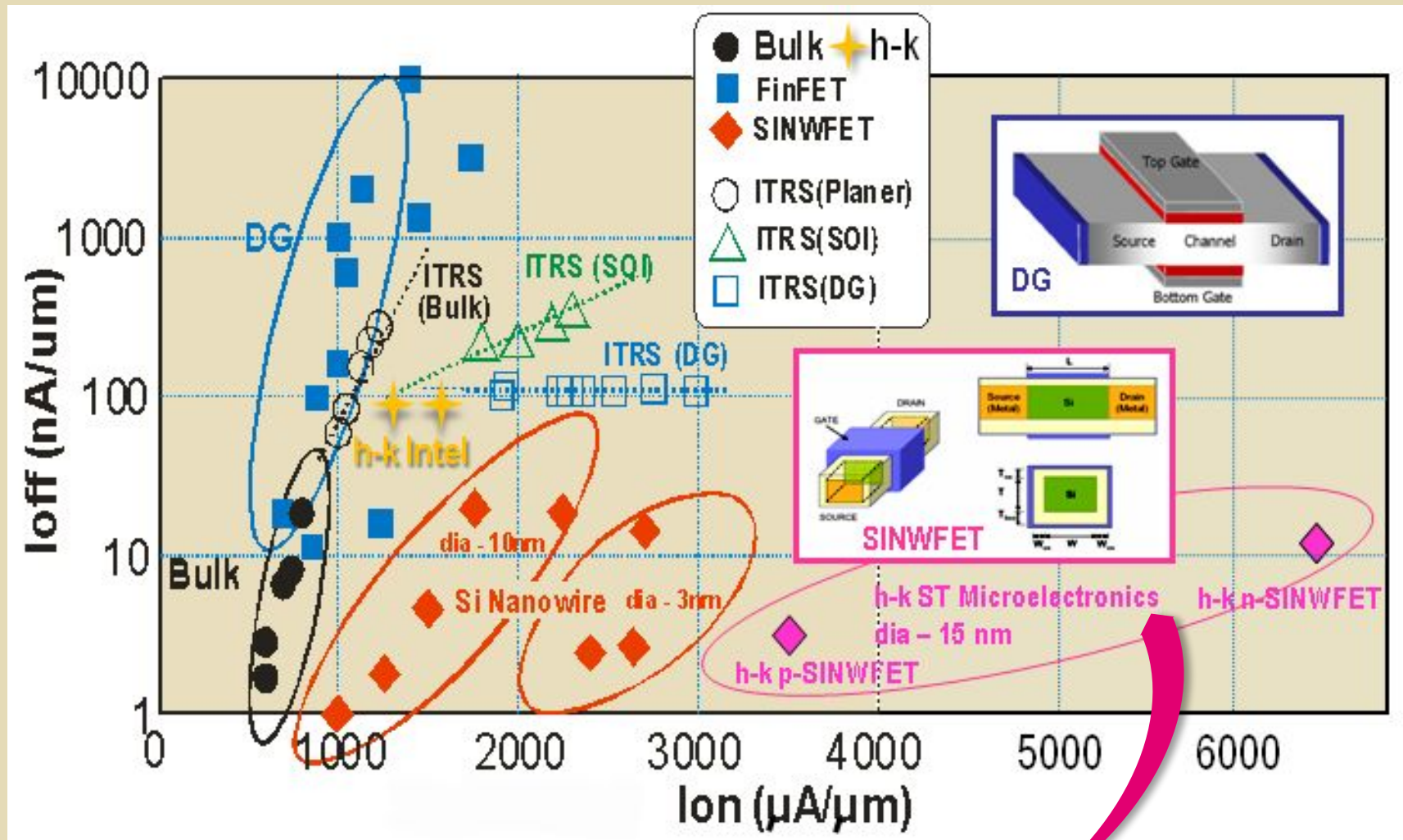
I_{on} / I_{off} разных типов нанотранзисторов

O.V. Naumova, M.A. Ilnitsky, L.N. Safronov, V.P. Popov.
 Semicond., v. 41, p.103-109, 2007

www.nanohub.org M. Lundstrom et al. IEEE Trans. on Elect. Dev., 55, 1286, 2008

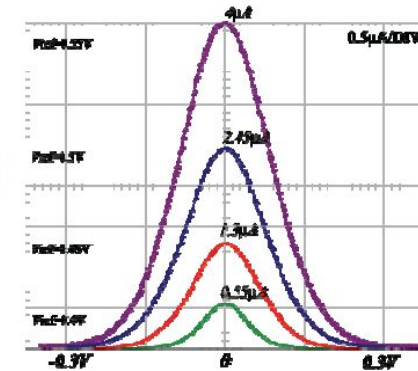
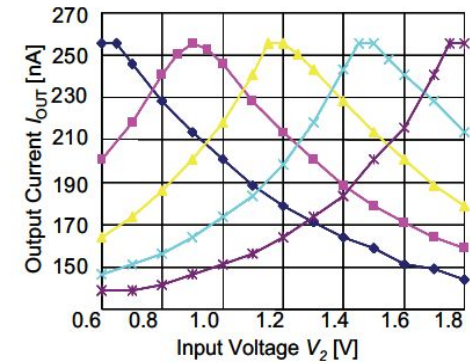
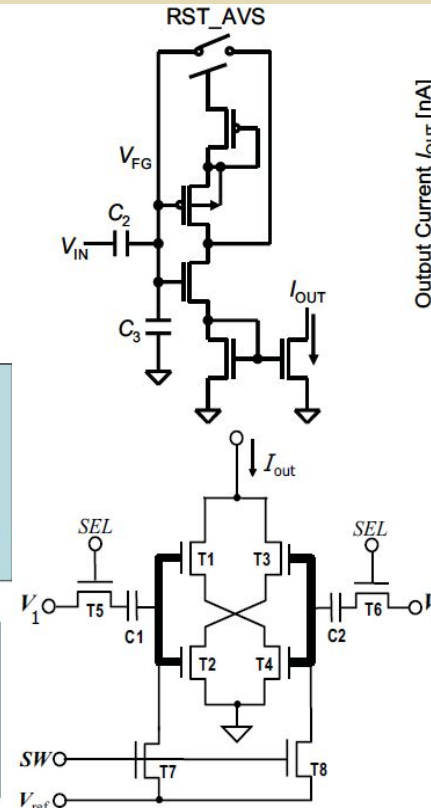
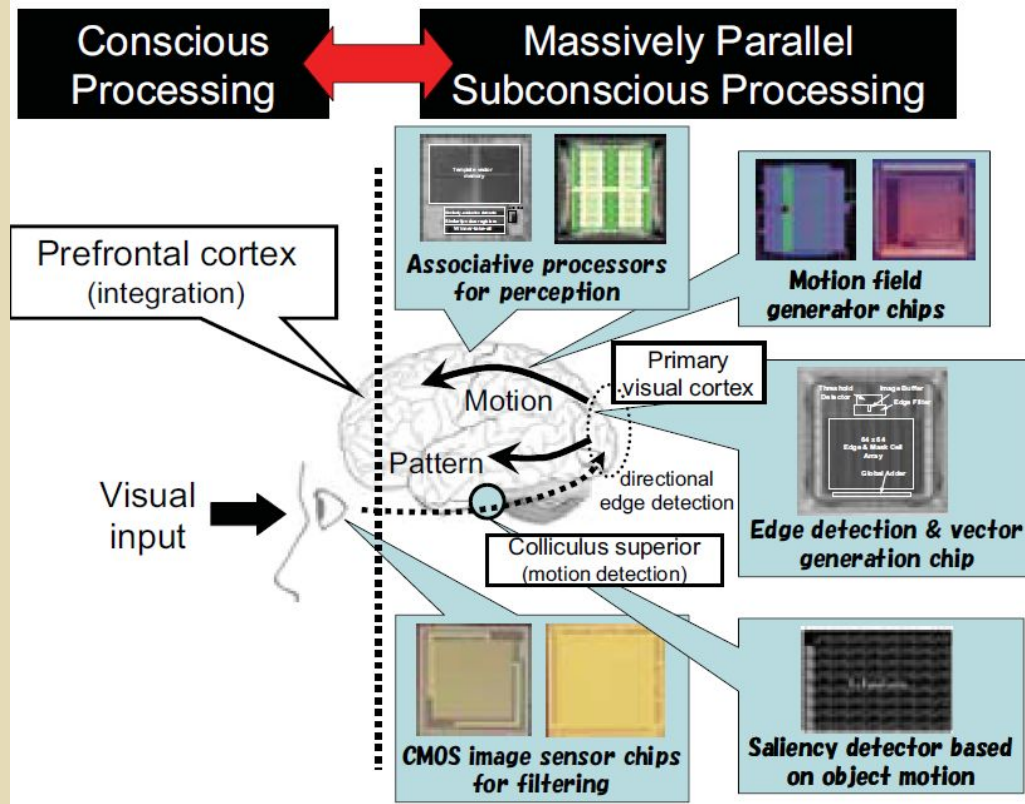
H. Iwai 4th Int. Symp. on Adv. Gate Stack Technol., 2007

Двухзатворные (DG) и нанопроволочные (SINW) транзисторы для СБИС



*IEDM 2008: high-k SiNWT with 10 nm
Intel high-k 32 nm technology*

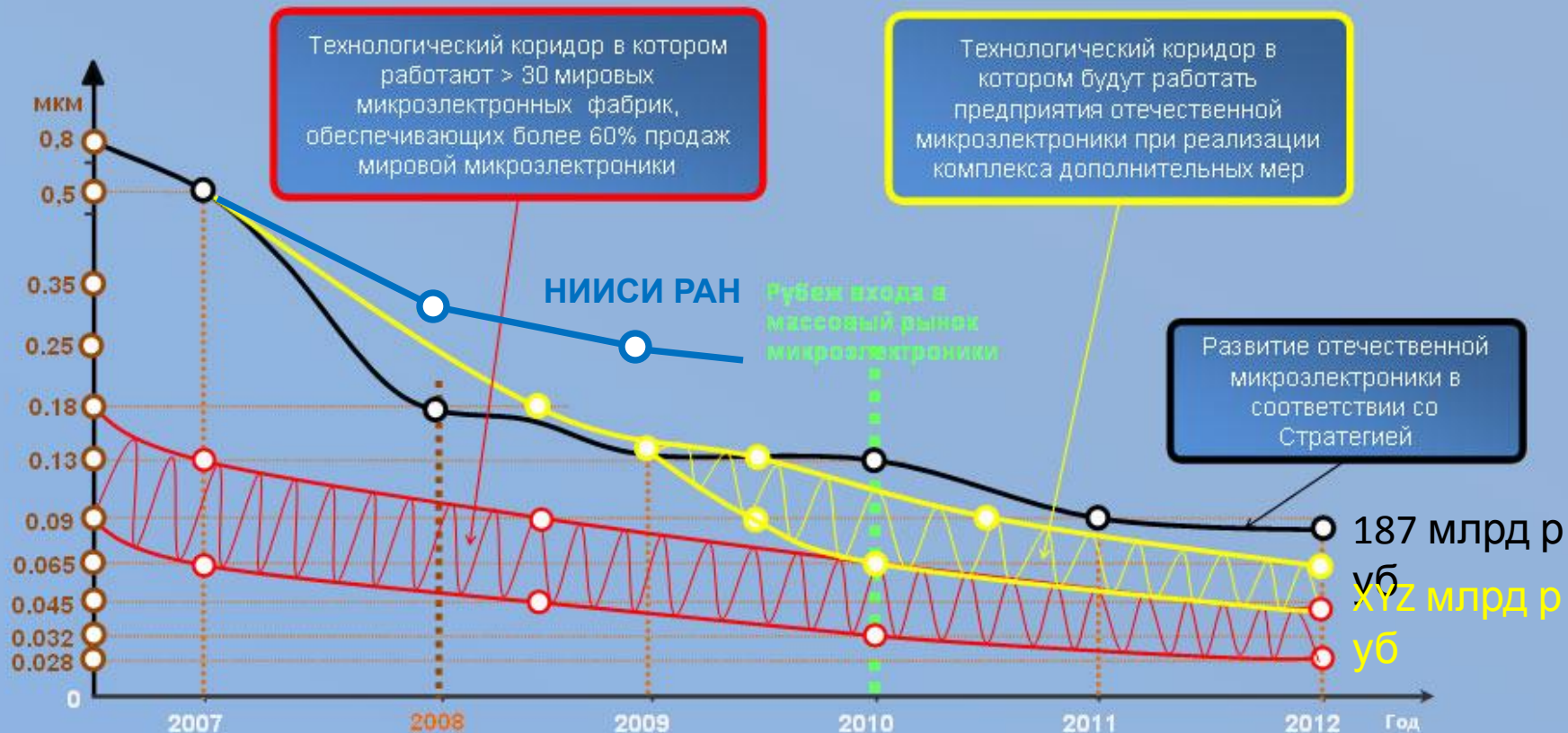
КМОП СБИС чип эмуляции процессов опознавания, обучения и принятия решений



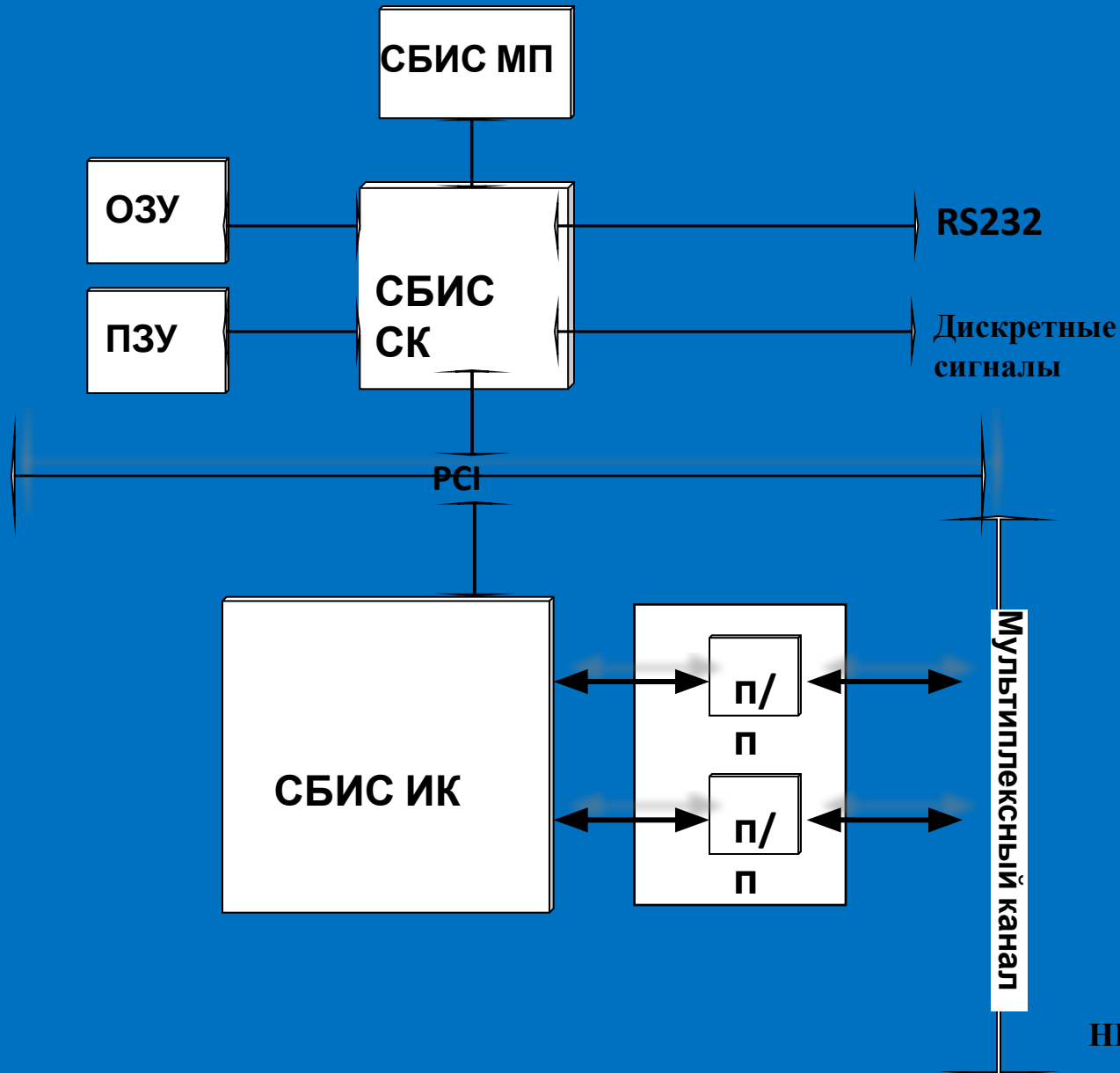
Архитектура кремниевого чипа с ~10 млрд. КМОП транзисторов, эмулирующих мозг (Тадаши Шибата)

Резонансные характеристики логики для ассоциативных «голосующих» процессоров на КМОП и ПМОП нанотранзисторах

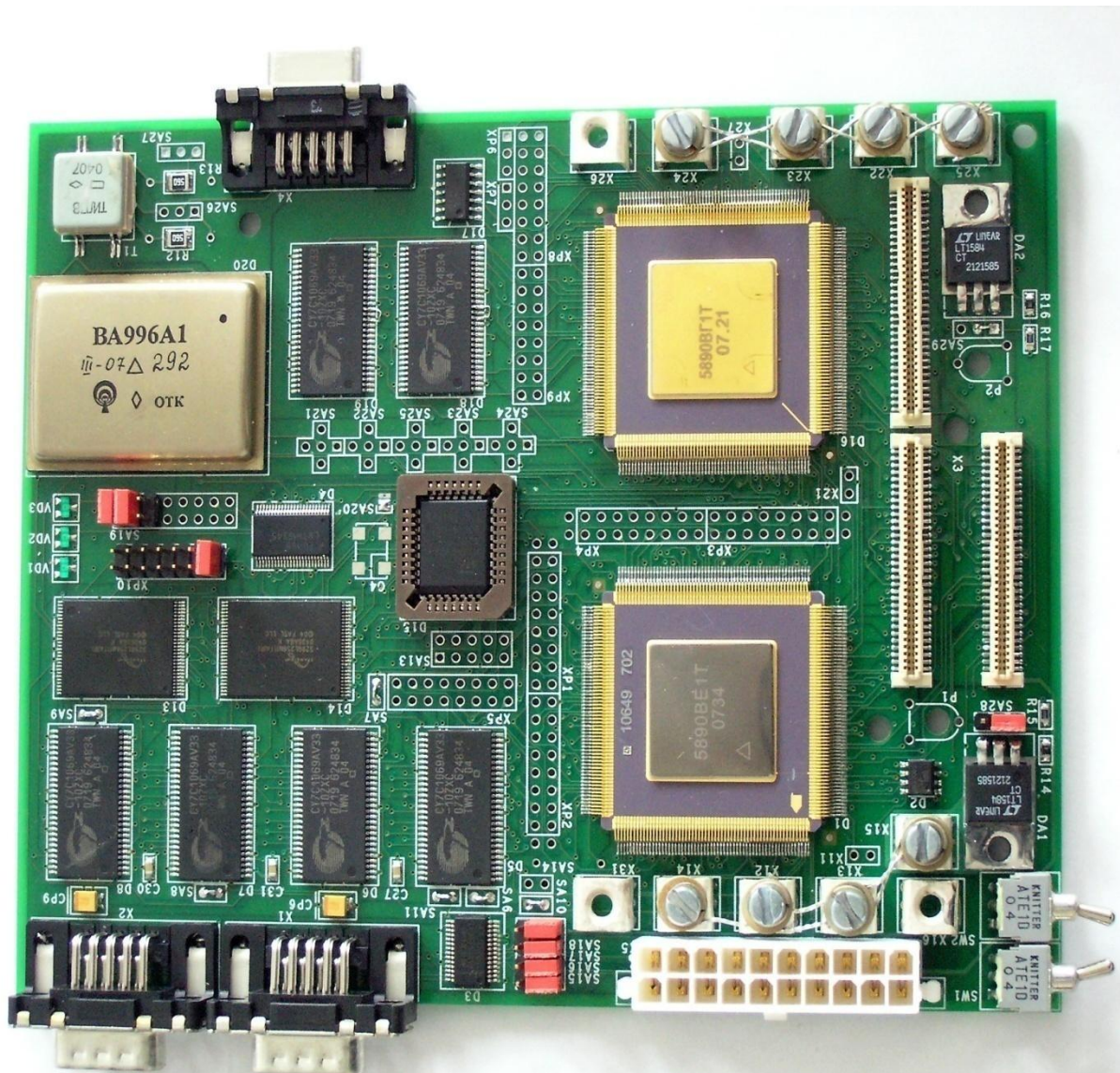
Техпроцессы системообразующей ЭКБ микроэлектроники



Структура управляющей ЭВМ с 32-разрядным RISC микропроцессором КОМДИВ32-С



Плата управляющей ЭВМ с 32-разрядным RISC микропроцессором КОМДИВ32-С



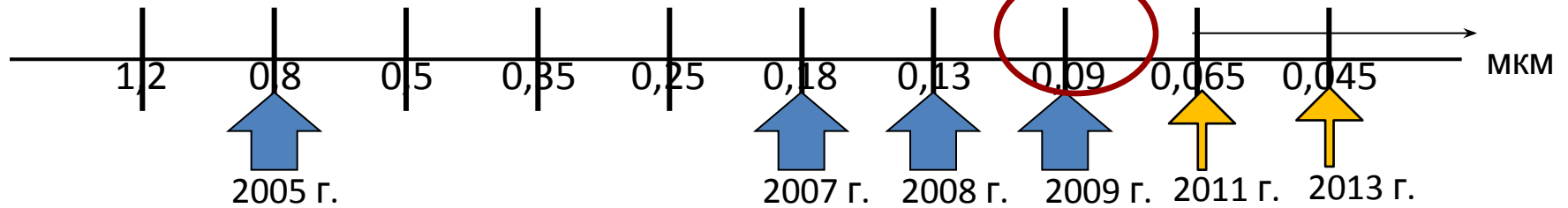


0.18 мкм технология ST Microelectronics 2007г.



Планы технологического развития «НИИМЭ и Микрон»

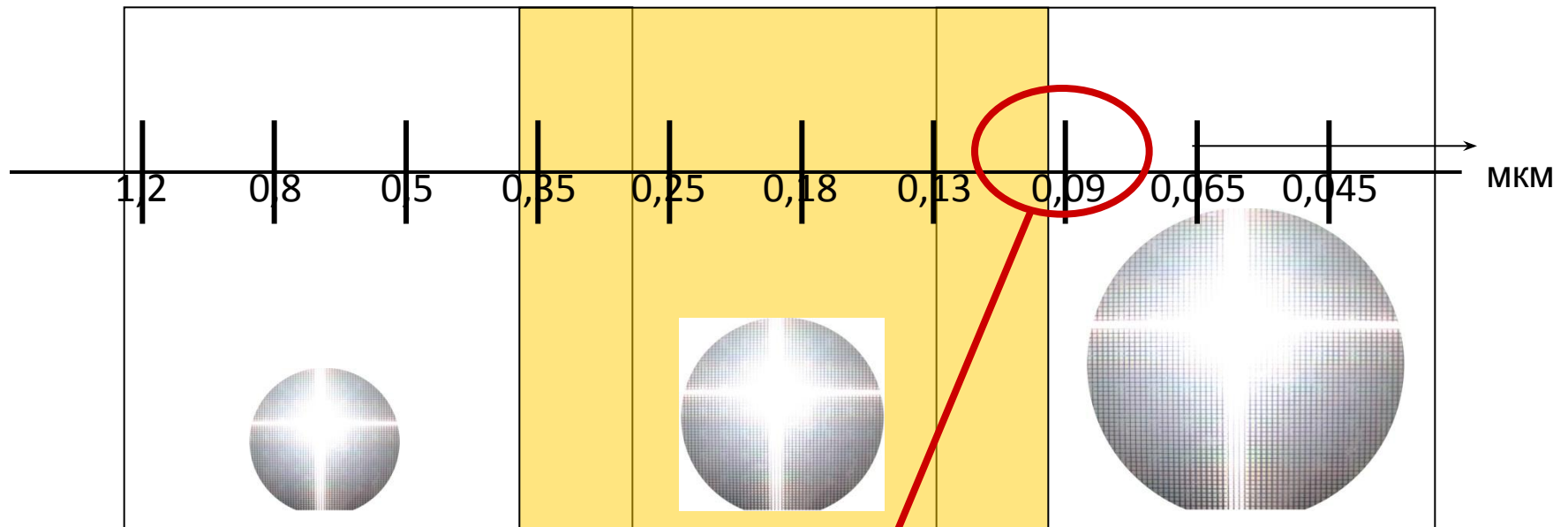
Модернизация 200мм фабрики в 2011г.
с Роснано



Фабрика «150мм»

Фабрика «200мм»

Фабрика «300мм»



Строительство новой 300мм фабрики
для уже существующей на 200мм технологии

Результаты и перспективы развития КМОП технологии

- - Имеющийся научно-технический задел по кремниевой КМОП технологии позволяет прогнозировать масштабированное уменьшение размеров от 45 нм до 4-5 нм в течение ближайших 20-25 лет. Дальнейший прогресс бинарной (цифровой) логики будет основан не на принципах переноса заряда или спина.
- - Существующий сегодня уровень интеграции в КМОП СБИС достаточен для формирования многопроцессорных параллельных систем, в том числе систем ассоциативной логики.
- - Одновременная разработка новых материалов (графена, п/п наноструктур, квантовых точек) и новой архитектуры микропроцессоров являются необходимым условием создания искусственного интеллекта, не уступающего по уровню человеку.
- - Отставание России от мировых лидеров в развитии подобных систем

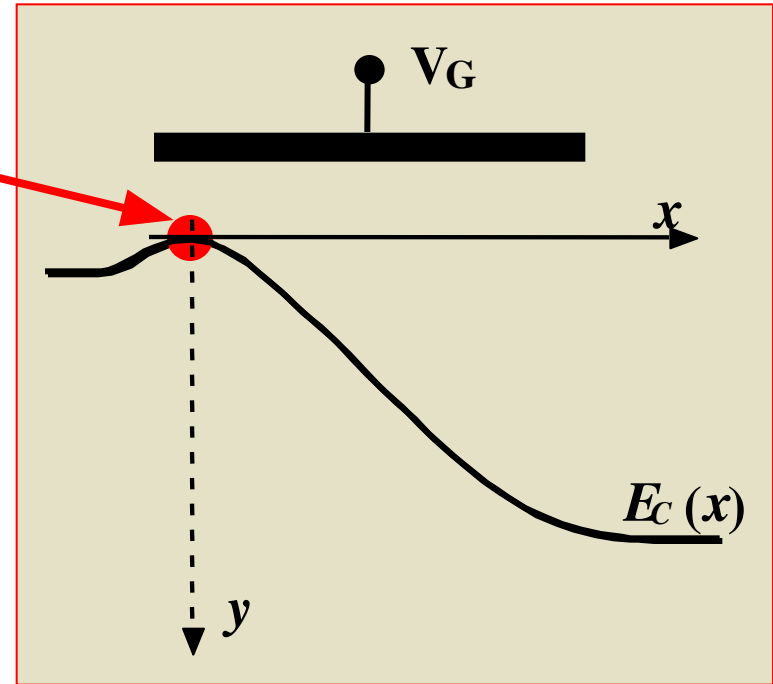
Проблема плотности тока при размерном квантовании

ток, зависящий от пропускания.....

квази-равновесие

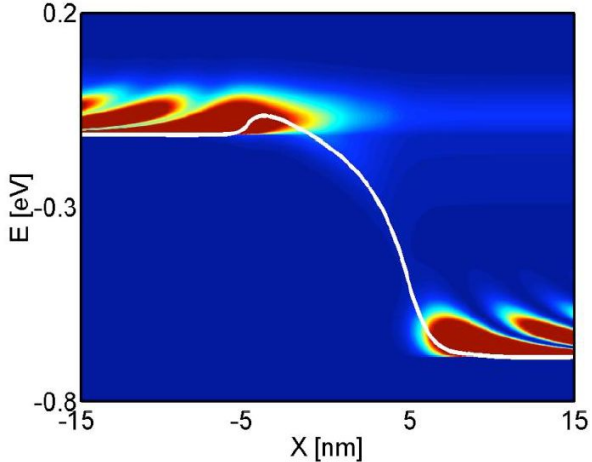
$$n_S(V_{GS}) = C_{eff}(V_{GS} - V_T)$$

Аппроксимация
плавного
канала + DIBL



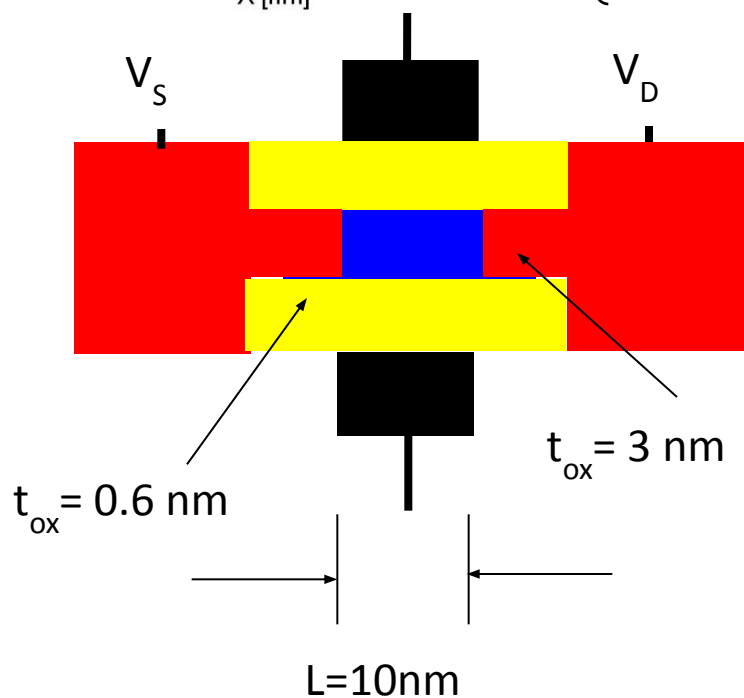
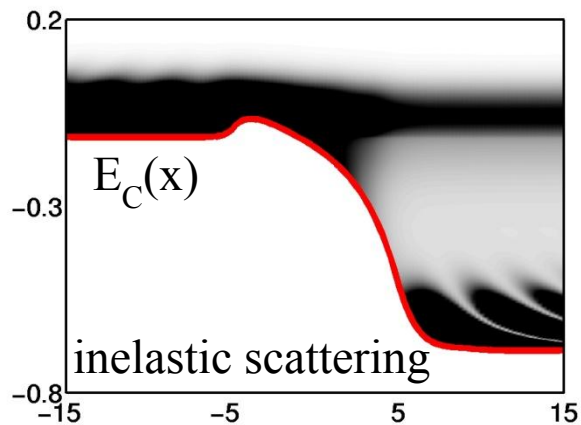
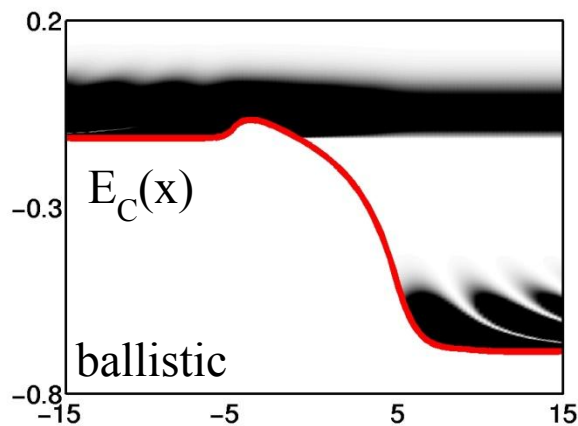
$$I_{DS} = W C_{ox} v_T (V_{GS} - V_T) \left[\frac{1 - e^{-qV_{DS}/k_B T_L}}{1 + e^{-qV_{DS}/k_B T_L}} \right] \quad v_T = \sqrt{\frac{2k_B T_L}{\pi m^*}}$$

(Статистика Больцмана и одна подзона)



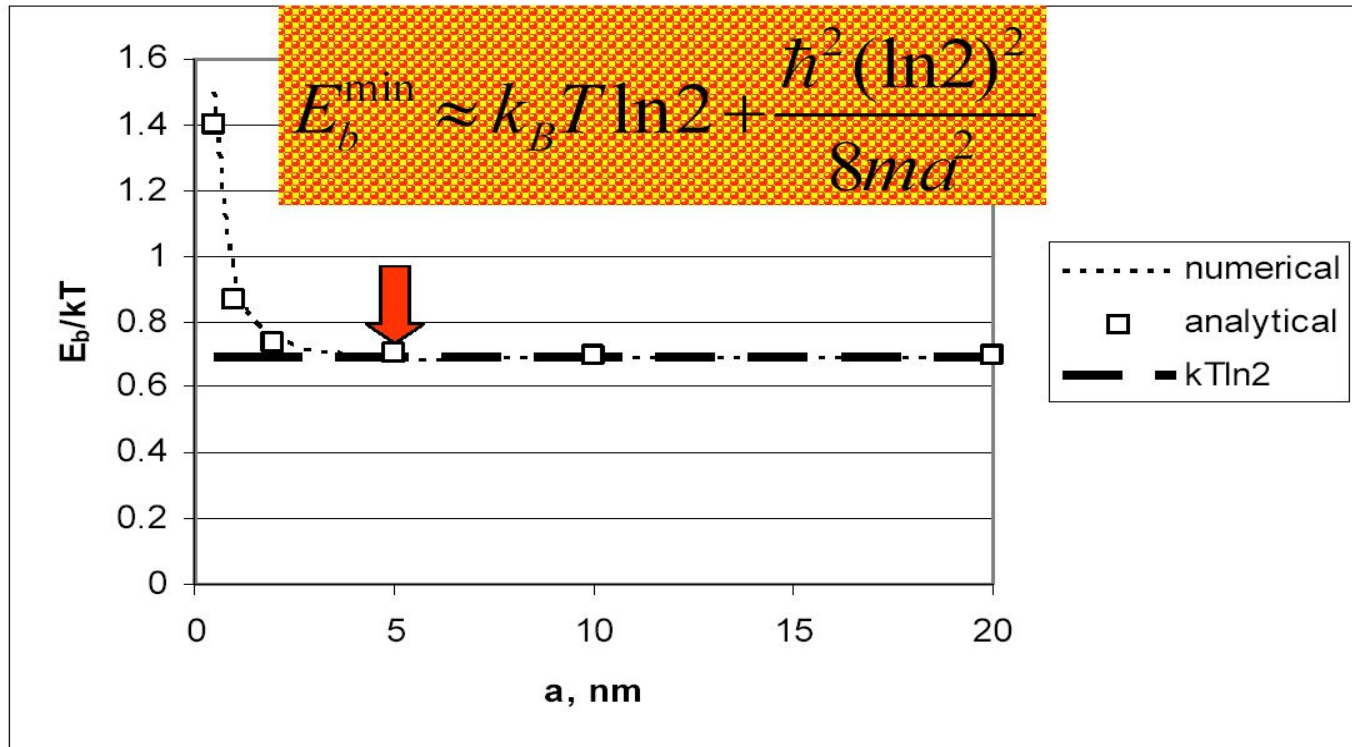
I-V characteristics of nano-MOSFETs

effective mass
Hamiltonian



Zhibin Ren and Ramesh Venugopal (Purdue)
Dejan Jovanovic (Motorola, Los Alamos)

5 nm MOS is Theoretically Feasible



Minimum energy per switch operation as a function of minimum switch size

Более реалистические оценки мощности

Сверху:

$$P = P_{\text{stat}} + P_{\text{dyn}} \approx 100 \text{ Вт} \cdot \text{см}^{-2}$$

где

$$P_{\text{stat}} = V_{DD} \cdot I_{\text{off}}$$

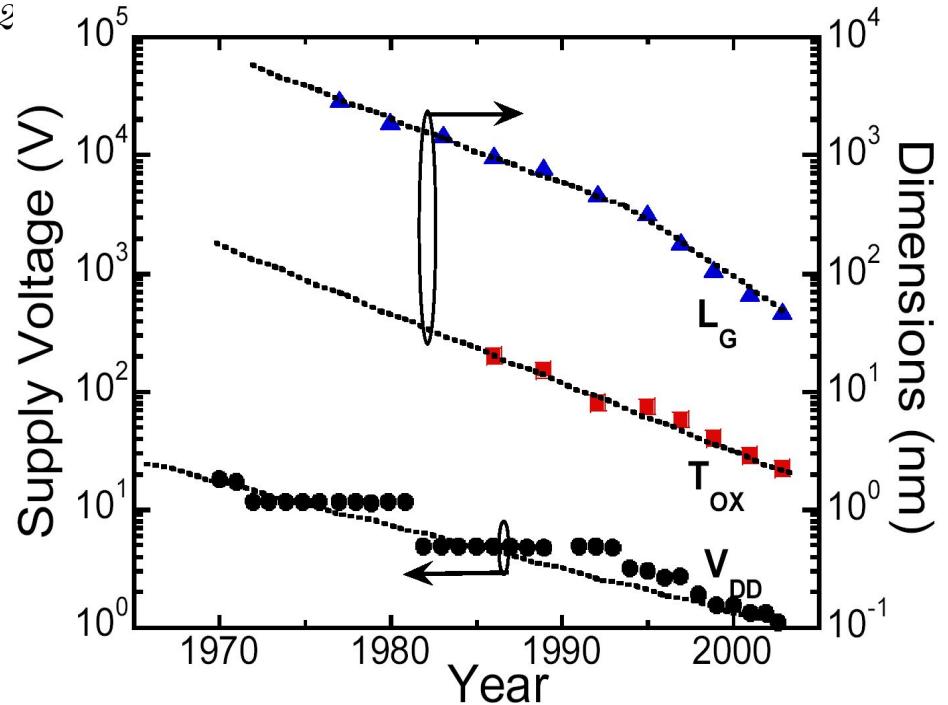
$$P_{\text{dyn}} = C \cdot V_{DD}^2 \cdot f$$

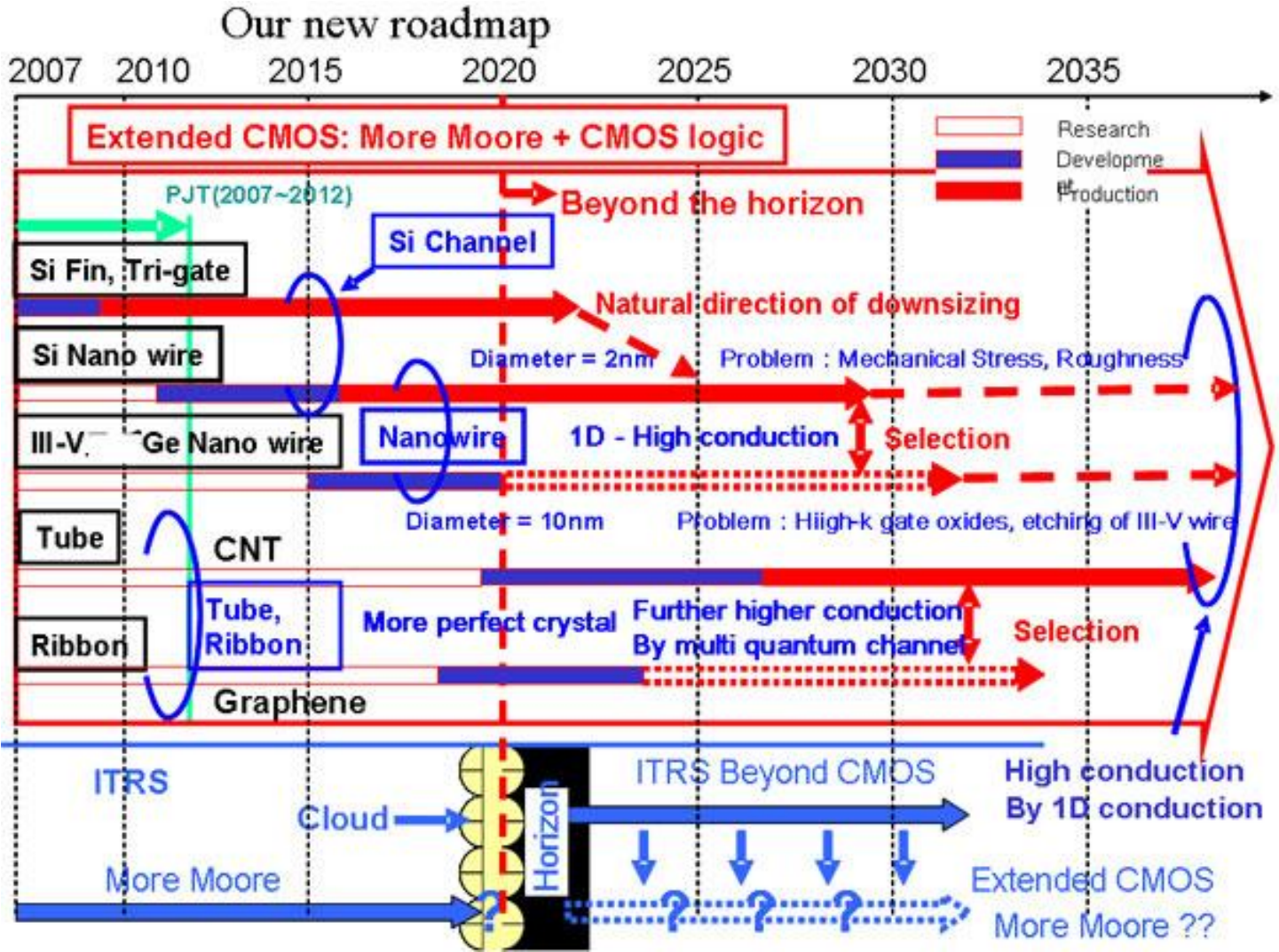
Снизу:

$$kTLn\left(\frac{N\tau_{mbf}}{\tau}\right) = C_L \cdot V_{\text{min}}^2$$

$$V_{\text{min}} = \left(\frac{kTLn\left(\frac{N\tau_{mbf}}{\tau}\right)}{C_L} \right)^{1/2} \approx 10 \text{ мВ} \quad T = 300 \text{ К}, C_L = 0.4 \text{ фФ} (t_{ox} = 1 \text{ нм})$$

$$N = 10^9, \tau = 10 \text{ пс}, \tau_{mbf} = 1000 \text{ ч}$$

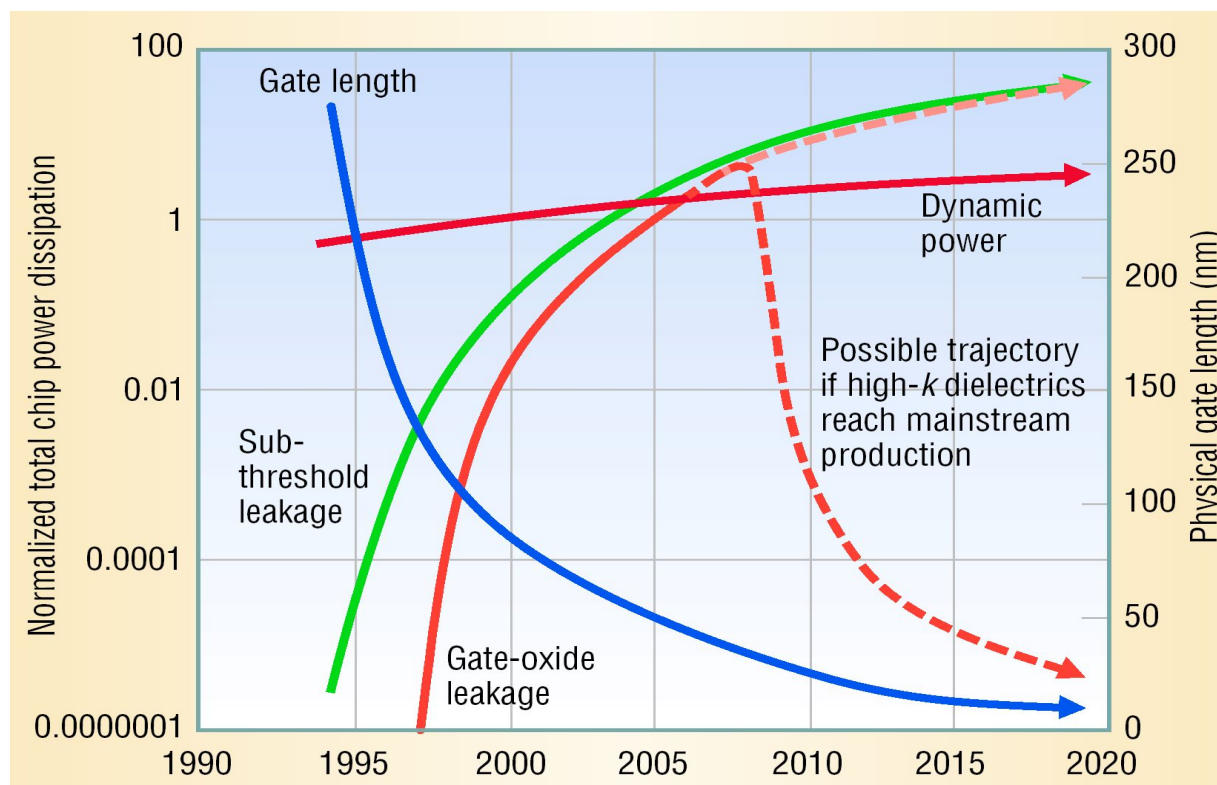




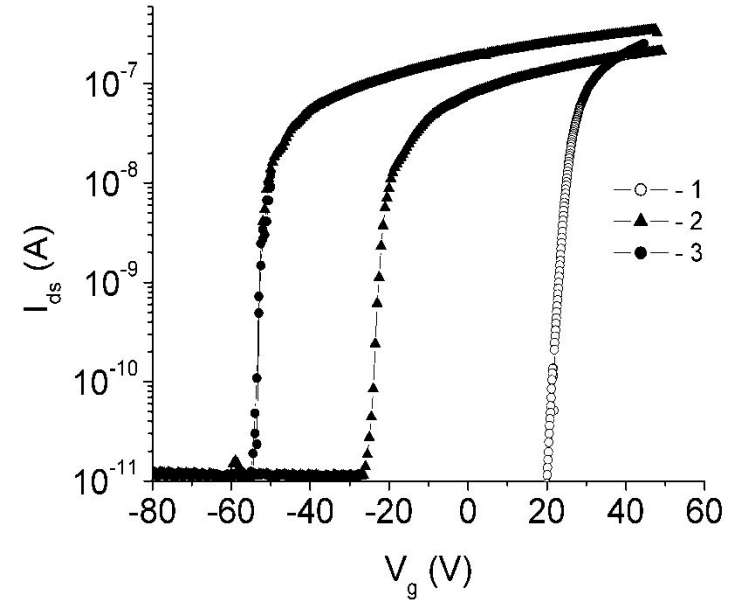
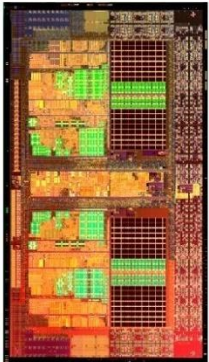
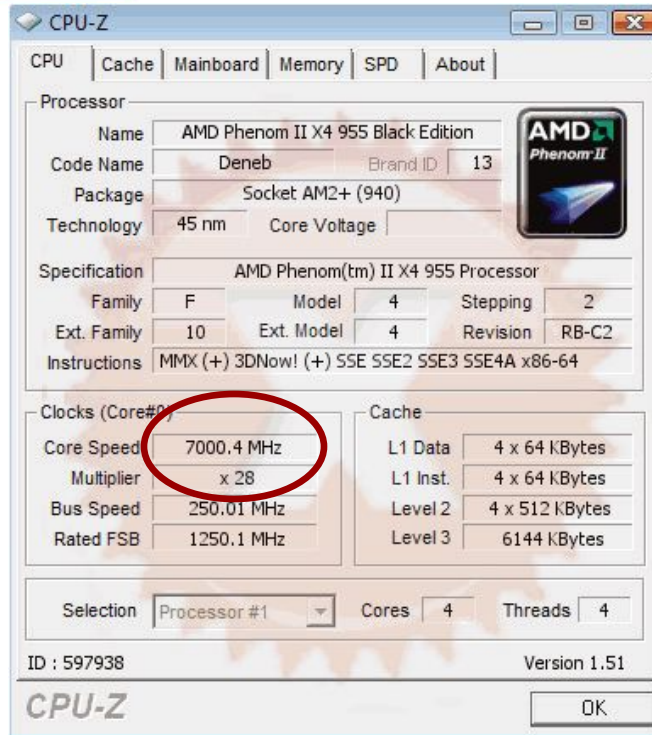
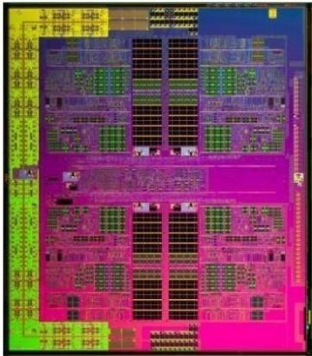
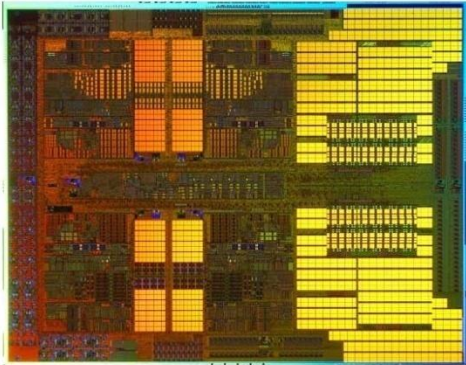
Hiroshi Iwai "Gate Stack Technology for the Next 25 Years"

4th International Symposium on Advanced Gate Stack Technology 25-28 September 2007 Dallas, Texas

Изменение потребляемой мощности СБИС при переходе к high-k диэлектрикам



Криогенная стабильность МП AMD Phenom II X4 и сдвиг сток-затворных характеристик КНИ нанопроволочных транзисторов



$I_{DS}-V_{DS}$ кривые КНПТ ($V_{ds}=0.15$ V)
измеренные при температуре :

- 1 – 300 K ;
- 2 – 14 K ;
- 3 – 7.3 K.

Адсорбционный газоанализатор !

КМОП криогенная наноэлектроника?